

将籽晶浸入硅熔液中进行引晶形成晶棒，并施加磁场强度为第一预设值的水平磁场，在所述晶棒的轴向方向上，所述水平磁场的最强高斯面与硅溶液的液面之间的第一距离小于第二预设值

对晶棒进行等径生长，并施加磁场强度为第三预设值的尖点磁场，所述尖点磁场的零磁面位于坩埚的R弧部位

图 1

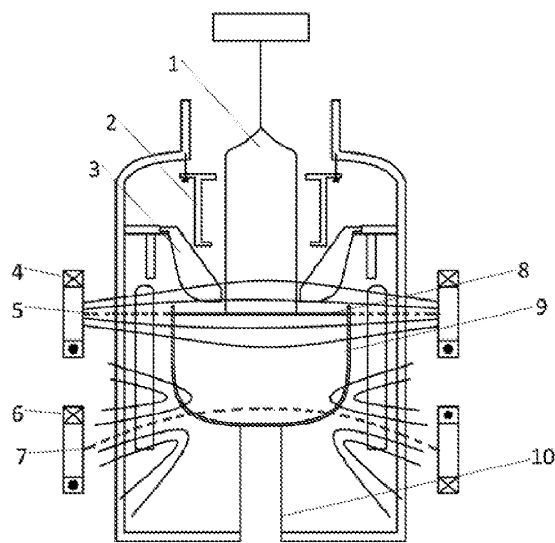


图 2

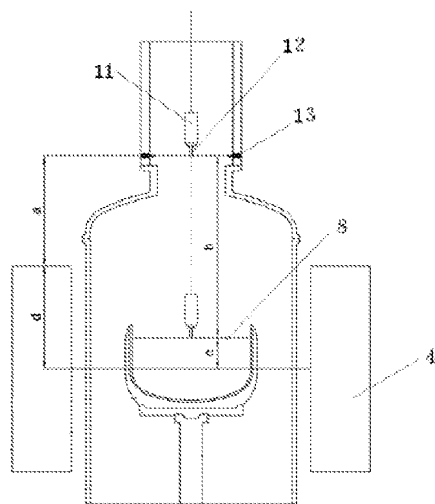


图 3